





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC8008ENGR

Hersteller-Teilenummer:

EPC8008ENGR

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 40V 2.7A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [1.EPC8008ENGR.pdf](#)

 [2.EPC8008ENGR.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2610 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	EPC8008ENGR
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 40V 2.7A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2610 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	325 mOhm @ 500mA, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	25pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.18nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC8007ENGR

EPC
TRANS GAN 40V 3.8A BUMPED
DIE



EPC8005ENGR

EPC
TRANS GAN 65V 2.9A BUMPED
DIE



EPC8010ENGR

EPC
TRANS GAN 100V 2.7A BUMPED
DIE



EPC8009ENGR

EPC
TRANS GAN 65V 4.1A BUMPED
DIE



EPC8009ENGR

EPC
TRANS GAN 65V 4.1A BUMPED
DIE



EPC8005ENGR

EPC
TRANS GAN 65V 2.9A BUMPED
DIE



EPC8008ENGR

EPC
TRANS GAN 40V 2.7A BUMPED
DIE



EPC8007ENGR

EPC
TRANS GAN 40V 3.8A BUMPED
DIE

EPC8008ENGR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC8008ENGR	EPC8008ENGR Datenblatt	EPC8008ENGR-Datenblätter	EPC8008ENGR PDF	EPC EPC8008ENGR
EPC8008ENGR Electronic	EPC8008ENGR-Komponenten	EPC8008ENGR-Verteiler	EPC8008ENGR-Bild	EPC8008ENGR-Teil
EPC8008ENGR Preis	EPC8008ENGR Hersteller	EPC8008ENGR Bild	EPC8008ENGR Aktie	EPC8008ENGR Inventar
EPC8008ENGR Neu	EPC8008ENGR Original	EPC8008ENGR garantiert	EPC8008ENGR RFQ	EPC8008ENGR Online bestellen